

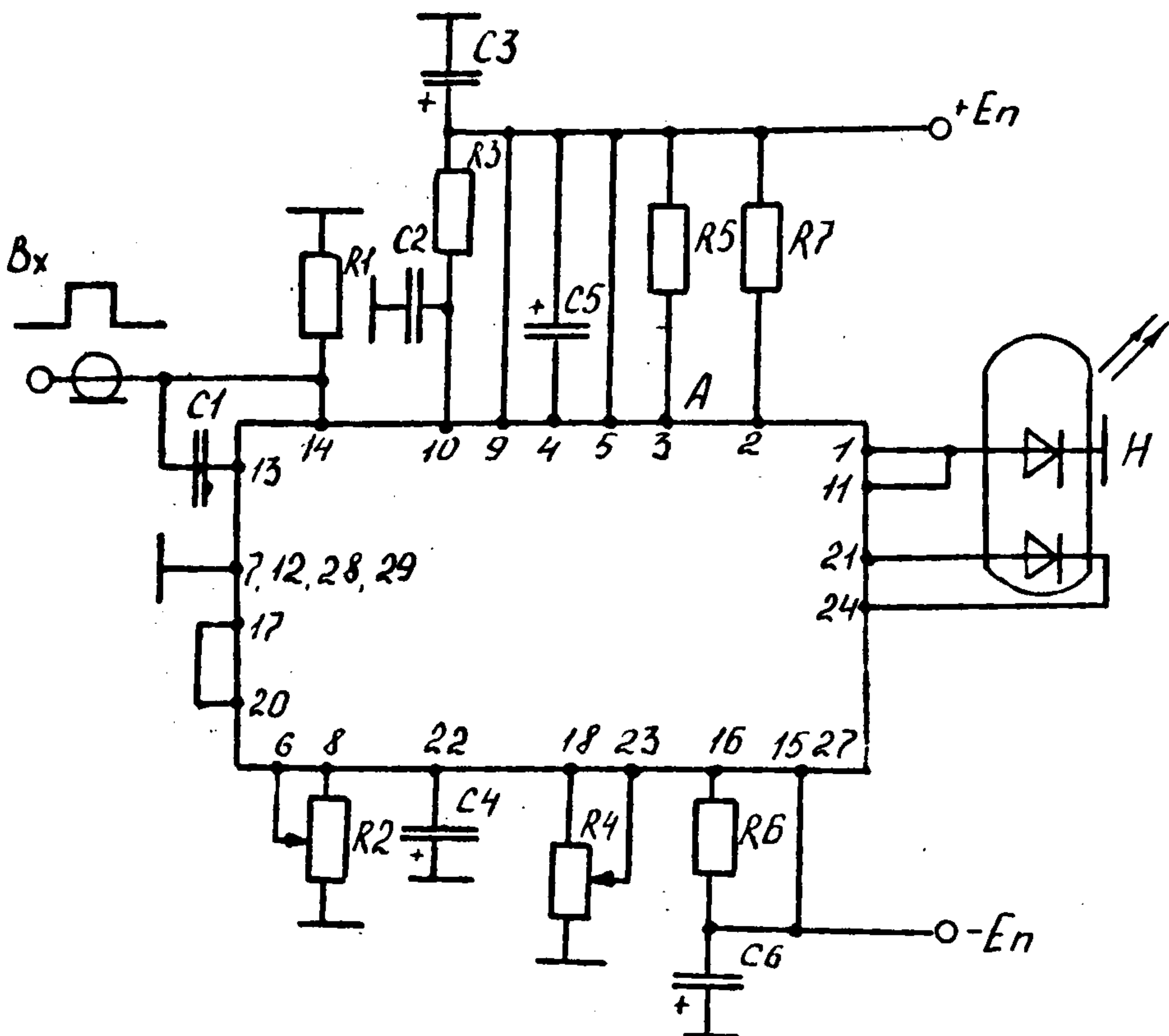
Рис. II

Таблица 1

Условное обозначение микро-схемы	Основное функциональное назначение	Классификационные параметры в нормальных климатических условиях (буквенное обозначение, ед. измерения)			Обозначение комплекта конструкторской документации	Обозначение схемы электрической	Обозначение габаритного чертежа	Условное обозначение корпуса	Обозначение описания образцов внешнего вида	Количество элементов в схеме электрической	
		Амплитудой регулирования	Длительность фронта и среза импульсов	Уровень выходного тока							С, I...0,9, 2 ф. Вых, 2 ср. Вых, не
		не менее	не менее	не более							
K854MI	Модуль лазерного излучения	10...45		3	РАДС.431331.001	РАДС.431331.001 ЭЗ	У 8С.073.014 ГЧ	157.29-1 ГОСТ 17467	РАДС.431331.001 Д2	162	

АЛБЖ, 431330.099 ГЧ

РЕКОМЕНДУЕМАЯ СХЕМА ВКЛЮЧЕНИЯ



- C1, C2 – 3...30 нФ подбираются в зависимости от амплитуды импульсов;
- C3, C4, C5, C6 – 10,0 мкФ – К53-1 или аналогичные;
- H – ИЛПН-203 – полупроводниковый излучатель;
- R1 – 62 Ом – согласующий резистор;
- R2, R4 – 470 Ом ± 10% с собственной емкостью менее 5 пФ;
- R3 ≥ 15 Ом определяет амплитуду импульса;
- R5, R7 – 10 Ом;
- R6 – 430 Ом.

Рис.3